ATR

20067016

技術の名称　# 半導体レーザ

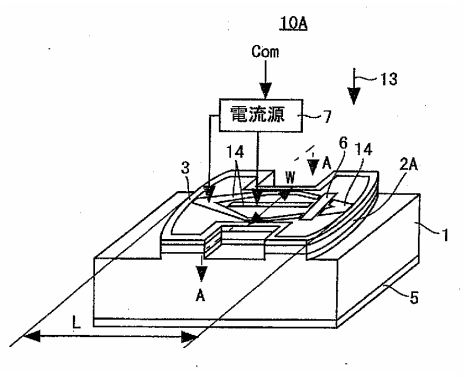
適用分野　半導体リングレーザ

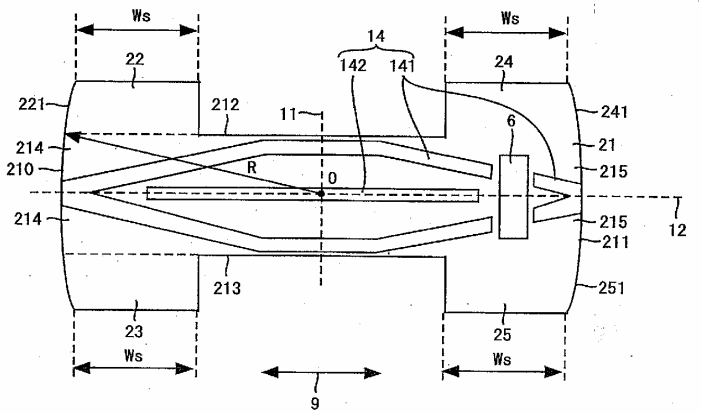
■ 目　　的　リングレーザチップ単体でリングレーザの発振モードの切り換えを可能とする。

■ 効　　果　本発明によれば、レーザの発振モード観測する観測部を設けたので、レーザ光を検出する為の検出部を別箇に設けることなく、リングレーザチップ単体で発振モードの切り換えが可能となる。

■ 技術概要　半導体基板1上にレーザ光を出射するキャビティ2Aが設けられており、このキャビティ2A表面のリング状の電極141と線状の電極142とからなる正極14が形成されると共に、リング状電極141の一部にレーザの発振モードを観測する観測部6が設けられており、この観測部6によってレーザの発振モードを観測しつつ電流源7からの電流を制御する。

■ 特記事項,図など





■ 主たる提供特許
特許等の名称：半導体レーザ
登録番号：
出願番号：特願2006－309414　　出願日：平成18年11月15日
公開番号：

■ 実施実績　○有、　無　　■ 提供形態　○実施許諾、　×権利譲渡

お問合せ先　株式会社　国際電気通信基礎技術研究所（ATR）　経営統括部　知的財産チーム
〒619－0288　京都「けいはんな学研都市」光台二丁目2番地2
TEL　0774－95－2521　　E-mail ; patent@atr.jp